

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-316382

(43)公開日 平成11年(1999)11月16日

(51)Int.Cl.⁶

G 0 2 F 1/1343
1/136

識別記号

5 0 0

F I

G 0 2 F 1/1343
1/136

5 0 0

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 17 頁)

(21)出願番号 特願平10-204136

(22)出願日 平成10年(1998) 7 月21日

(31)優先権主張番号 特願平10-53123

(32)優先日 平10(1998) 3 月 5 日

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 伴 厚志

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 山川 真弥

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 久保 真澄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 弁理士 小池 隆彌

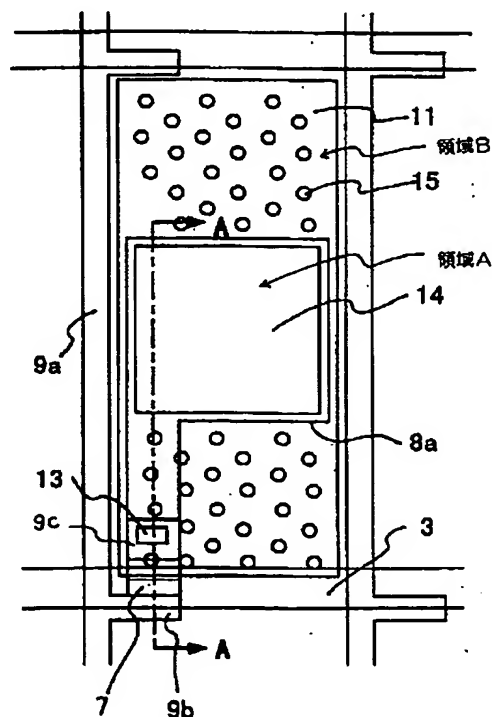
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示パネル及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 透過型表示と反射型表示を1枚の基板で同時に行なう液晶表示パネルを、従来の液晶表示パネルよりも周囲光及び照明光(バックライト光)の利用効率を向上させ、品質を安定化させると共に製造を簡略化した液晶表示パネルを提供することを目的とする。

【解決手段】 絶縁性基板1上に、複数のゲート配線3と複数のソース配線9aが直交するように配設され、前記配線の交差部近傍にはTFT7が設けられている。TFT7のドレイン電極9cには画素電極として反射電極11と透過電極8aが接続されている。これら画素電極が形成された部分は、基板上方から観察すると光透過効率の高い領域Aと光反射効率の高い領域Bの2つの領域からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に複数のゲート配線と、該ゲート配線と直交するように配置された複数のソース配線とによって包囲される複数の画素からなり、該画素内に、前記ゲート配線と前記ソース配線の交差部付近に設けられたスイッチング素子と、該スイッチング素子に接続された画素電極とが形成され、透過型表示と反射型表示とが同時に行われる液晶表示パネルにおいて、前記画素電極は、互いに電氣的に接続された光透過効率の高い第一の導電層と光反射効率の高い第二の導電層とを同一画素領域内に有していることを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項 2】 前記第一の導電層と第二の導電層とが、互いに絶縁層を介して別層に設けられていることを特徴とする請求項 1 記載の液晶表示パネル。

【請求項 3】 前記第一の導電層と第二の導電層とが、第三の導電層を介して接続されていることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の液晶表示パネル。

【請求項 4】 前記第一の導電層、第二の導電層または第三の導電層が、前記ゲート配線またはソース配線を構成している材料の一部と同一の材料からなることを特徴とする請求項 1 から 3 の何れか記載の液晶表示パネル。

【請求項 5】 前記絶縁層のうち、前記第二の導電層に対応する表面は複数の凹凸を有していることを特徴とする請求項 1 から 4 の何れか記載の液晶表示パネル。

【請求項 6】 請求項 2 から 5 の何れか記載の液晶表示パネルの製造方法において、
順に、前記第一の導電層を形成する工程と、
少なくとも、前記第一の導電層上に前記絶縁層を成膜する工程と、
前記絶縁層上に前記第二の導電層を成膜する工程と、
前記第一の導電層上に形成された前記第二の導電層の一部を除去する工程とを含むことを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【請求項 7】 請求項 3 から 5 の何れか記載の液晶表示パネルの製造方法において、
前記第一の導電層を形成する工程と、
少なくとも前記第一の導電層上の、前記第一の導電層と第二の導電層との接続領域に相当する部分に前記第三の導電層を形成する工程と、
前記絶縁層を成膜する工程と、
少なくとも前記第一の導電層と第二の導電層との接続領域に相当する部分の前記絶縁層を除去する工程と、
前記第二の導電層を成膜する工程と、
前記第一の導電層上に形成された前記第二の導電層の一部を除去する工程と、を含むことを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【請求項 8】 前記絶縁層を除去する工程と、前記第一の導電層上の一部に存在する絶縁層を除去する工程とを同時に行なうことを特徴とする請求項 7 記載の液晶表示

パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、透過型、反射型、もしくはその併用型として使用できる液晶表示パネル及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】液晶表示パネルは、薄型で低消費電力であるという特長を生かして、ワードプロセッサやパーソナルコンピュータなどのOA機器や、電子手帳等の携帯情報機器、あるいは、液晶モニターを備えたカメラ一体型VTR等に広く用いられている。

【0003】また、上記液晶表示パネルに搭載する液晶表示パネルはCRT（ブラウン管）やEL（エレクトロルミネッセンス）表示とは異なり自らは発光しないため、バックライトと呼ばれる蛍光管からなる照明装置をその背面または側方に設置して、バックライト光の透過量を液晶表示パネルで制御して画像表示を行なう所謂透過型液晶表示パネルがよく用いられている。

【0004】しかしながら、透過型液晶表示パネルでは、通常バックライトが液晶表示パネルの全消費電力のうち50%以上を占めるため、バックライトを設けることで消費電力が増大してしまう。

【0005】また、透過型液晶表示パネルは反射型液晶表示パネルとは逆に、周囲光が非常に明るい場合には周囲光に比べて表示光が暗く見え、表示を認識することが困難であった。

【0006】よって、上記透過型液晶表示パネルとは別途、戸外や常時携帯して使用する機械の多い携帯情報機器ではバックライトの代わりに一方基板に反射板を設置し、周囲光を反射板表面で反射させることにより表示を行なう反射型液晶表示パネルが用いられている。

【0007】しかしながら、周囲光の反射光を利用する反射型液晶表示パネルは、周囲光が暗い場合には視認性が極端に低下するという欠点を有する。

【0008】また、このような反射型液晶表示パネルでは、低消費電力を目的として周囲光を利用して表示を行なうため、十分な電源を供給できる環境下でも周囲光がある限界値よりも暗い場合には表示を認識することができなくなる。このことは、反射型液晶表示パネルの最大の欠点であった。

【0009】また、その製造において反射電極の反射特性がばらつくと周囲光の利用効率にもばらつきが生じるため、表示を認識することができなくなる周囲光強度もパネル間でばらつくことになる。そのため、製造の際には従来の透過型液晶表示パネルにおける開口率のばらつき以上に反射特性のばらつきを制御しなければ安定した表示特性を有する液晶表示パネルを得ることができなかった。

【0010】以上のような反射型液晶表示パネル及び透

3

過型液晶表示パネルの問題点を解消するために、従来では特開平 7-333598 号公報に示されるように、バックライト光の一部を透過させると共に、周囲光の一部を反射させるような半透過反射膜を用いることにより、透過型表示と反射型表示の両方を一つの液晶表示パネルにて実現する構成が開示されている。

【0011】図 16 に上記半透過反射膜を用いた液晶表示パネルを示す。液晶表示パネルは、偏光板 30、位相差板 31、透明基板 32、ブラックマスク 33、対向電極 34、配向膜 35、液晶層 36、MIM 37、画素電極 38、光源 39、反射膜 40 から構成されている。

【0012】半透過反射膜である画素電極 38 は、金属粒子を画素内一面にごく薄く堆積させるか、或いは、面内に微小な孔欠陥や凹入欠陥等が点在するよう形成されたものであり、光源 39 からの光を、画素電極 38 を透過させると共に、自然光や室内照明光等の外光を画素電極 38 で反射させることによって透過型表示機能と反射型表示機能とを同時に実現することができる。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図 16 に示された表示装置では以下のような不具合が生じる。まず、上述の半透過反射膜として金属粒子をごく薄く堆積させたものを用いた場合、吸収係数の大きな材料を用いる必要があるため入射光の内部吸収が大きく、また表示に利用されない吸収光や散乱光が生じてしまい光の利用効率が悪い（例えば、ある機種では 55% の光が表示に利用されない）という問題を有していた。

【0014】他方、画素電極 38 として面内に微小な孔欠陥や凹入欠陥等（以下、開口部と称する）が点在する膜を用いた場合、膜の構造があまりにも複雑で、製造においては緻密な設計条件が伴うために膜質の制御が困難であり、均一な特性の膜を製造することが困難であるという問題を有していた。言い換えれば、電気特性や光学特性の再現性が悪く、液晶表示パネルとして表示品位を制御することが極めて困難であった。

【0015】本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、透過型表示と反射型表示を一枚の基板で同時に行なう液晶表示パネルを、従来の液晶表示パネルよりも周囲光及び照明光（バックライト光）の利用効率を向上させ、品質を安定化させると共に製造を簡単化した液晶表示パネル及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0016】

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示パネルは、基板上に複数のゲート配線と、該ゲート配線と直交するように配置された複数のソース配線とによって包囲される複数の画素からなり、該画素内に、前記ゲート配線と前記ソース配線の交差部付近に設けられたスイッチング素子と、該スイッチング素子に接続された画素電極とが形成され、透過型表示と反射型表示とが同時に行わ

4

れる液晶表示パネルにおいて、前記画素電極は、互いに電氣的に接続された光透過効率の高い第一の導電層と光反射効率の高い第二の導電層とを同一画素領域内に有していることを特徴とし、そのことにより上記課題が解決される。

【0017】前記第一の導電層と第二の導電層とが、互いに絶縁層を介して別層に設けられていることが好ましい。

【0018】前記第一の導電層と第二の導電層とが、第三の導電層を介して接続されていることがさらに好ましい。

【0019】また、望ましくは前記第一の導電層、第二の導電層または第三の導電層が、前記ゲート配線またはソース配線を構成している材料の一部と同一の材料からなる。

【0020】さらに望ましくは、前記絶縁層のうち、前記第二の導電層に対応する表面は複数の凹凸を有している。

【0021】本発明の液晶表示パネルの製造方法は、順に、前記第一の導電層を形成する工程と、少なくとも、前記第一の導電層上に前記絶縁層を成膜する工程と、前記絶縁層上に前記第二の導電層を成膜する工程と、前記第一の導電層上に形成された前記第二の導電層の一部を除去する工程とを含むことを特徴とし、そのことにより上記課題が解決される。

【0022】また、他の前記液晶表示パネルの製造方法においては、前記第一の導電層を形成する工程と、少なくとも前記第一の導電層上の、前記第一の導電層と第二の導電層との接続領域に相当する部分に前記第三の導電層を形成する工程と、前記絶縁層を成膜する工程と、少なくとも前記第一の導電層と第二の導電層との接続領域に相当する部分の前記絶縁層を除去する工程と、前記第二の導電層を成膜する工程と、前記第一の導電層上に形成された前記第二の導電層の一部を除去する工程と、を含むことを特徴とを特徴し、そのことにより上記課題が解決される。

【0023】さらに、前記絶縁層を除去する工程と、前記第一の導電層上の一部に存在する絶縁層を除去する工程とを同時に行なうことが好ましい。

【0024】以下、上記構成による作用を説明する。

【0025】本発明の請求項 1 によれば、画素電極が、互いに電氣的に接続された光透過効率の高い第一の導電層と光反射効率の高い第二の導電層とを同一画素領域内に有しているので、従来のハーフミラーを用いた液晶表示パネルと比較して周囲光や照明光をロスなく利用する事ができ、格段に光の利用効率を向上させることができる。第一の導電層としては例えば透明導電性膜であるITOやSnO₂等、第二の導電層としてはAl、W、Crやそれらの合金等、何れも一般的な反射型液晶表示パネルや透過型液晶表示パネルに使用している材料を用い

ることができるため製造が簡単で、表示特性及び信頼性が非常に安定した液晶表示パネルを実現することができる。

【0026】また、従来の透過型液晶表示パネルが有していた、周囲光が明るい環境下で表面反射により視認性が低下するという課題と、従来の反射型液晶表示パネルが有していた、周囲光が暗い環境下でパネル輝度低下により表示観察が困難となるという課題の、両方を同時に解消することができると共に、何れの特長をも有する優れたものとなった。すなわち、本発明の液晶表示パネルは十分な電源を供給できる環境下では従来の透過型液晶表示パネルと同様にバックライト光を利用するため、周囲光の強度にかかわらず表示認識が可能となり、上述の反射特性のばらつきによる周囲光の利用効率のばらつきも反射型液晶表示パネルほど緻密に制御する必要はない。使用にあたっては、同一の画素内に存在する第一の導電層を有する光透過効率の高い領域と第二の導電層とを有する光反射効率の高い領域が相補的に表示に寄与するので、周囲光がどんな明るさであっても画像は鮮明に表示される。

【0027】さらに、本発明の液晶表示パネルをバッテリー駆動方式のデジタルカメラやビデオカメラのビューファインダー（モニター画面）として採用したところ、周囲光がどのような明るさであっても、バックライトの輝度を調節することによって常に観察しやすい明るさに保つことができた。

【0028】特に、晴天下、屋外にて使用した際には従来の透過型液晶表示装置ではバックライトの輝度を高くしても表示がかすんでしまい見づらくなる。このような時はバックライトを消して反射型表示として、或いは、バックライトの輝度を低くして透過型表示と反射型表示を併用することで、観察上の画質が向上し、電力消費量を少なくすることができる。他方、明るい日差しが差し込む室内にて使用した際には被写体の方向によって反射型表示と透過型表示とを切替えたり、或いは、それらを併用することによって見やすい表示とすることができる。モニター画面に日が差し込む場合には晴天下の屋外で使用した場合と同様に使用すればよい。また、部屋の薄暗い隅から被写体を撮影する場合にはバックライトを使用して透過型表示と併用すればよい。

【0029】さらに、本発明の液晶表示パネルをカーナビゲーション等の車載用のモニター画面として採用したときも、周囲光がどのような明るさであっても常に観察しやすい表示を行なうことが可能となる。従来の透過型液晶表示装置を使用した車載用モニターは、パソコン等に使用されるバックライトよりも高い輝度のバックライトが使用されている。その理由は、晴天下や外部からの光が画面に差し込む場合に対応するためである。しかしながら、それでも表示がかすんでしまっ

る場合には、昼間やトンネル外と同様のバックライトの輝度のままでは明るすぎて見にくいという不具合が生じていた。このようなときにも、本発明の液晶表示パネルによれば、常に反射型表示を併用することが可能なので、バックライトの輝度を高く設定しなくても明るい環境下では良好な表示を実現できる。また、真つ暗な環境下であっても少しの輝度（約50～100cd/m²）で点灯するだけで見やすい表示を実現することができる。

10 【0030】請求項2の発明によれば、画素電極を構成する第一の導電層と第二の導電層とが互いに絶縁層を介して別層に設けられている。上記請求項1によれば、第一の導電層と第二の導電層の領域で、絶縁層の膜厚を変更することによって液晶層の層厚を制御することができる。このことにより、両領域における光学特性の整合をとることができる。一方、製造工程においても互いに異なる電極電位を有する二層が絶縁層を介してそれぞれ存在している。よって、画素電極のパターニング時の現像液やレジスト剥離時の剥離液等を電解液として電食反応を生じることがないので、信頼性の高い液晶表示パネルを得ることができる。

20 【0031】例えば、本発明のように絶縁層を挟まずに画素電極の二層（例えば下層にITO、上層にA1）を続けて形成する場合、A1層とITO層との電極電位差が極めて大きく、薄膜中には多くの欠陥部（微小な開口部）が存在しているので、画素電極のパターニング時の現像液やレジスト剥離時の剥離液等を電解液として電食反応を生じてITO層の溶出が進行し、画素欠陥、配線の断線、液晶層の汚染を招きやすい。これに対し、本発明のように間に絶縁層を形成することにより、この絶縁層が保護膜となって電食反応の原因となる液の浸入等を防ぐことができる。

30 【0032】請求項3の発明によれば、画素電極を構成する二層が電食を発生しやすい関係にあっても、その両者の性質を緩和させるような第三の導電層を介して接続されているので、より電食反応による接触不良や信頼性の低下を抑止することが可能となる。

40 【0033】請求項4の発明によれば、第一、第二、第三の導電層の何れかが、ゲート配線またはソース配線の材料の一部と同一であるので、製造プロセスを簡略することが可能となる。

【0034】請求項5の発明によれば、絶縁層のうち、第二の導電層が形成される表面は複数の凹凸を有しているので、周囲光を反射させるだけでなく、外部へ散乱させることができ、広い視野角を得ることで、別途散乱板を使用することなくペーパーホワイト表示が可能となる。

50 【0035】本発明の請求項6及び7の液晶表示パネルの製造方法によれば、従来のハーフミラーを用いた液晶表示パネルのような複雑な製造条件は必要でなく、従来

7

の透過型液晶表示パネルや反射型液晶表示パネルに用いた一般的な電極材料や配線材料ならびに製造条件を用いればよいと、容易に製造することができ、その再現性も良好である。また、第一の導電層と第二の導電層とが電食を起こしやすい関係にあっても、絶縁層や第三の導電層を介在させることにより両者が直接接したり、電解液に触れることがない状態で製造することができる。したがって、電食反応の発生が抑止され、高い信頼性を有する液晶表示パネルを効率よく提供することができる。

【0036】また、請求項8によれば、第一の導電層と第二の導電層との接続領域に対応する部分の絶縁層を除去する工程と、第一の導電層上の一部に存在する絶縁層を除去する工程とを同時に行なうので、工程数を増やすことなく高い信頼性を有する液晶表示パネルを得ることができる。

【0037】

【発明の実施の形態】（実施形態1）本発明の実施形態1の液晶表示パネルに関し、図面に基づき以下に説明を行なう。図1は本実施形態の液晶表示パネルにおけるアクティブマトリクス基板の部分平面図であり、図2は図1のA-A断面図である。

【0038】図1において、ガラスまたはプラスチック等からなる透明な絶縁性基板1（図示せず）上に、複数のゲート配線3と複数のソース配線9aが直交するように配設され、前記配線の交差点近傍にはTFT7が設けられている。TFT7のドレイン電極9cには画素電極として反射電極11と透過電極8aが接続されている。これら画素電極が形成された部分は、基板上方から観察すると光透過効率の高い領域Aと光反射効率の高い領域Bの2つの領域からなる。

【0039】また、図示しないが、図1のアクティブマトリクス基板の表面には液晶配向機能を有する配向膜が設けられている。

【0040】本実施形態及び以下の実施形態に係る液晶表示パネルは、以上のようなアクティブマトリクス基板が、透明電極及び配向膜を備えた対向基板とを貼り合わせ、基板間に液晶が封入されてなるものである。尚、必要に応じ、カラーフィルタや位相差板、偏光板等が別途備え付けられていてもよい。

【0041】本実施形態では、領域Aは絵素中央部に位置する四角形であり、その断面構造は光透過効率の高い材料が積層されてなると共にTFT7のドレイン電極9cに接続された透過電極8aを画素電極として備えている。他方、領域Bは上記領域Aを包囲するようにして形成され、その上面にはTFT7のドレイン電極9cに接続された光反射効率の高いA1またはA1系合金からなる反射電極11を画素電極として備えている。これにより領域Bは入射光を外部へ効率よく反射させることができる。また、反射電極11はさらにその表面になだらかな凹凸形状を有しているので、入射光を適度な範囲へ散

8

乱させることができるような構成となっている。

【0042】尚、液晶としては、黒色色素を混入したゲストホスト液晶ZLI2327（メルク社製）に、光学活性物質S-811（メルク社製）を0.5%混入したものをを用いた。

【0043】図2において、上記TFT7はゲート配線3（図1に示す）から分岐するゲート電極2の上部に、ゲート絶縁膜4、半導体層5、半導体コンタクト層6a、6b、ソース電極9b及びドレイン電極9cが順に積層されてなる。

【0044】TFT7のドレイン電極9cには透過電極8aが接続されており、この透過電極8aが画素電極の役割をなしている。前記領域Bに相当する部分には透過電極8aの上部に層間絶縁膜10及び反射電極11が設けられており、この反射電極11は層間絶縁膜10に形成されたコンタクトホール13を介して下部の透過電極8aと電気的に接続されて、透過電極8aと同様に液晶に電圧を印加するための画素電極となっている。このとき、透過電極8aと反射電極11とは直接接続せず、間に導電性の金属層12を挟むことによって電気的に接続させている。

【0045】これを製造するプロセスにおいては、反射電極11のパターン形成時に透過電極8a上を絶縁層10で被覆しておくことができるため（詳細は下記にて説明）、ITOとA1とが電食反応を生じて、配線が断線する等の不具合を効果的に防止することができる。また、透過電極8a上に絶縁層10をある程度薄く残し、完全に透過電極8aを覆う構造とすることで、製造後もITOとA1との間で電食反応を生じるのを防止できる。

【0046】尚、本実施形態では上記金属層12としてTiを用いたがこの限りではなく、A1系以外の導電性材料であればCr、Mo、Ta、W等の材料を用いても同様の効果を得ることが可能である。或いは、金属層12を形成する代わりに、上記反射電極11として、A1〜W、Ni、Pd、V、Zr等の、A1よりも電極電位の高い金属材料を添加したA1系合金材料を用いることによっても、上記ITOとA1との間の電食反応を抑止することが可能である。例えば、A1にWを5.0at%程度添加することにより上述の電食反応をより効果的に抑止することができる。

【0047】以下、本実施形態のアクティブマトリクス基板の製造方法について図3に基づき説明を行なう。まず、図3(a)に示すように、絶縁性基板1の上に導電性薄膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて所望の形状にパターニングし、ゲート電極2、ゲート配線（図示せず）を形成する。本実施形態では、絶縁性基板1としてはガラス、ゲート電極2及びゲート配線3の材料（以下、ゲート材料と称する）としてTaを用いた。但し、絶縁性基板1としてはガラス以外にもプラスチッ

ク等の材料を用いても構わない。また、ゲート材料としてもAl、Cr、Mo、W、Cu、Ti等の導電性を有する他の材料でも構わない。

【0048】次に、図3(b)に示すように、ゲート絶縁膜4、半導体層5、半導体コンタクト層6a、6bを成膜する。本実施形態ではゲート絶縁膜4としてSiNx、半導体層5としてa-Si、半導体コンタクト層6a、6bとしてPをドープしたn+型a-SiをCVD法で連続成膜した。そして、フォトリソグラフィ技術を用いて所定の形状にパターンニングを行い、半導体層5と半導体コンタクト層6a、6bを形成する。

【0049】次に導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて所定の形状にパターンニングし、ソース配線9a、ソース電極9b、ドレイン電極9cを形成する。本実施形態では導電膜としてCr系材料を用いた。但し本材料としてはAl、Mo、Ta、W、Cu、Ti等の導電性を有する他の材料でも構わない。

【0050】次に、図3(c)に示すように、光透過性を有する導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて透過電極8aを形成する。本実施形態ではこの透過電極8aとしてITOを用いた。

【0051】次に、金属膜を成膜しフォトリソグラフィ技術を用いて金属層12を形成する。この金属層12は、前記透過電極8aと後の工程にて形成する反射電極11とを接続する際に両者を介するもので、本実施形態では材料としてTiを用いた。但し、Al系以外の材料であればCr、Mo、Ta、W等の他の材料でも構わない。

【0052】次にソース電極9b、ドレイン電極9cをマスクとして半導体コンタクト層をエッチングし、半導体コンタクト層としてソース側6a、とドレイン側6bに分けることでTFT7を形成する。

【0053】このときソース、ドレイン電極層9a、9b、9cが、透過電極8aの上層に形成されていても構わない。

【0054】次に、図3(d)に示すように、層間絶縁膜10を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて後にコンタクトホール13、透過領域(領域A)等となる部分を層間絶縁膜10から削除する。またこれと同時に、領域B、すなわち反射電極11を形成する部分の層間絶縁膜10上になだらかな凹凸部15を形成する。

【0055】尚、領域Aに対応する部分の層間絶縁膜10を除去することにより、領域Aの透過率を向上させることができる。但し、本実施形態のように完全に除去しなくてもよく、ある程度残存させてもよいし、或いは全く除去するものでなくとも構わない。例えば、除去する膜厚を制御することにより、液晶にかかる電圧を領域Aと領域Bとで互いに等しくすることができる。すなわち、液晶の配向状態を画素内で略均一にできる。

【0056】また、基板端部に設けられている配線の接

続端子上にも絶縁層が形成されている場合にはその絶縁層をこの工程と同時に除去してもよい。すなわち、ソース配線端子部分、ゲート配線端子部分にはICドライバ等と接続するための接続電極がITOで形成されていることが多いが、この接続電極上に直接Al電極を形成する場合、画素部と同様の電食反応が発生することがある。そこで、ITOとAlとの間に絶縁層を設けることで問題は解決されるが、最終的に接続電極上の絶縁層を除去しなければならないので、この除去を画素部の領域A上の層間絶縁膜10を除去する工程と同時に行なえば工程数を増すことがなく好適である。

【0057】本実施形態の凹凸部15の形状は、上方から観察したときに円形をしており(図1、3に示す)、その断面は連続的に変化するなだらかな形状のものである。このように、表面に凹凸部15を備えた層間絶縁膜10の上に、次工程にて形成される反射電極11が設けられると、入射光が反射電極11表面で効率よく反射されると共に、その反射光を適度な方向へ散乱させることができる。尚、形成する凹凸部15の形状は所望とする表示特性に応じて適宜決定すればよく、或いは、反射光を散乱させる必要のない場合等には上記凹凸部15を形成しなくてもよい。

【0058】尚、本実施形態では層間絶縁膜10として単層(2.5μm程度)の有機樹脂を用いたがこれに限定されることはなく、異なる複数の材料からなる積層膜であっても構わない。しかし本実施形態のように、有機樹脂からなる層間絶縁膜10を比較的厚く形成すると、TFT7の上部にも反射電極11の一部を重畳させても、寄生容量が発生することはなく、表示品位が良好かつ開口率の高い液晶表示パネルとなる。また、このように厚い有機樹脂層であれば、上記凹凸部15の形成も行いやすい。

【0059】或いは、この層間絶縁膜の代わりに、SiNxを初めとする一般的な無機膜を絶縁層として用いても構わない。但し、一般的に比較的薄くても高い絶縁性を得ることができる代わりに、エッチングによる凹凸形成は困難となりやすい。しかし、所望とする液晶表示パネルの表示特性により、凹凸部を形成する必要はない場合には好適である。

【0060】続いて、図3(e)に示すように、Alを成膜し、フォトリソグラフィ技術によって領域Bに相当する部分をパターンニングして反射電極11を形成する。この反射電極11はコンタクトホール13及び金属層12を介して下部の透過電極8a、TFT7のドレイン電極9cと電気的に接続される。本実施形態では反射電極11としてAlを用いたがこの限りではなく、Al系の合金材料又は光反射光率の高い導電性材料であっても構わない。以上の工程によりアクティブマトリクス基板が完成する。

【0061】また、図示しないが、以上のアクティブマ

トリクス基板の表面に配向膜を形成し、この基板と透明電極及び配向膜を備えた対向基板とを貼り合わせ、基板間に液晶を封入することにより本実施形態の液晶表示パネルが完成する。必要であればカラーフィルタや位相差板等を別途備え付けてもよい。

【0062】尚、液晶としては、黒色色素を混入したゲストホスト液晶 ZLI2327（メルク社製）に、光学活性物質 S-811（メルク社製）を 0.5% 混入したものをを用いた。

【0063】また、本実施形態では領域 A と領域 B の面積比率を 40:60 とすることにより、良好な表示特性を有する液晶表示パネルを得ることができた。尚、面積比率はこの値に限定されることはなく、領域 A、B の透過効率または反射効率、及び使用目的に応じて適宜変更してもよい。また、本実施形態では領域 A を画素中央部に 1 箇所のみ設けたがこれに限定されることはなく、複数箇所分割されていても構わないし、その形状も四角形に限らない。

【0064】以上説明した本実施形態の液晶表示パネルや、以下に示す実施形態の液晶表示パネルでは、画素電極 6 として画素中央部に光透過効率の高い領域 A を、それ以外に光反射効率の高い領域 B を設けているので、従来のハーフミラーを用いた液晶表示パネルと比較して周囲光や照明光をロスなく利用する事が可能となる。また、液晶表示パネルは従来の透過型液晶表示パネルにおいて周囲光が明るい環境下で表面反射により視認性が低下するという課題と、従来の反射型液晶表示パネルにおいて周囲光が暗い環境下でパネル輝度低下により表示観察が困難となるとする課題の、両方を同時に解消することができると共に、何れの特長をも有する優れたものとなった。すなわち、本発明の液晶表示パネルは周囲光の強度にかかわらず表示認識が可能となり、上述の反射特性のばらつきによる周囲光の利用効率のばらつきも反射型液晶表示パネルほど緻密に制御する必要はない。

【0065】また、本実施形態の液晶表示パネルの製造方法については、従来のハーフミラーを用いた液晶表示パネルのように複雑な製造条件は必要でなく、従来の透過型液晶表示パネルや反射型液晶表示パネルに用いた一般的な電極材料や配線材料ならびに製造条件を用いればよいから、比較的容易に製造することができ、その再現性も良好である。また、従来のハーフミラーを用いた液晶表示パネルでは困難であった、表示特性の制御等も比較的容易に行なうことができる。

【0066】（実施形態 2）本発明の実施形態 2 の液晶表示パネルに関し、図面に基づき以下に説明を行なう。図 4 は本実施形態の液晶表示パネルにおけるアクティブマトリクス基板の部分平面図であり、図 5 は図 4 の B-B 断面図である。

【0067】本実施形態の液晶表示パネル及びその製造方法は、画素電極としての反射電極 11 と TFT 7 との

電気的接続構造及びその構成にかかわる製造方法が上記実施形態 1 と相違する。

【0068】図 4、5 において、TFT 7 のドレイン電極には透過電極 8a が接続されており、この透過電極 8a は領域 A において液晶に電圧を印加する画素電極として機能する。前記領域 B に相当する部分には透過電極 8a の上部に層間絶縁膜 10 及び反射電極 11 が設けられており、この反射電極 11 は層間絶縁膜 10 に形成されたコンタクトホール 13 を介して下部のドレイン電極 9c に直接接続され、前記透過電極 8a と同様に画素電極として機能する。本実施形態においても上記実施形態 1 と同様に、透過電極 8a の材料である ITO と反射電極 11 の材料である Al とを直接接続させない構成となっているため、領域 B では Al による周囲光の高い光反射効率を、他方の領域 A では ITO によるバックライト光の高い透過効率を有しながら、TFT とこれらの材料との電気的接続を電食等のおそれなく確実に行なうことが可能となる。

【0069】尚、本実施形態では ITO と Al との電食反応に関して記載しているが、本発明はこの組合わせにのみに適用されるということではなく、電食反応の生じ易い、互いに異なる電極電位を有する異種の材料の組合せに対して用いれば効果的である。

【0070】以下に、本実施形態のアクティブマトリクス基板の製造方法について説明を行なう。TFT 7 の半導体層 5 と半導体コンタクト層 6a、6b の一島をパターンニングするところまでは上記実施形態 1 と同様である。

【0071】次に導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて所望の形状にパターンニングしてソース配線 9a、ソース電極 9b、ドレイン電極 9c、接続用金属層 9d を形成する。本実施形態では導電膜として Cr 系材料を用いた。但し、本材料としては Al、Mo、Ta、W、Cu、Ti 等の導電性を有する他の材料でも構わない。

【0072】続いて、上記実施形態 1 と同様の透過電極 8a を形成する。このとき、透過電極 8a を接続用金属層 9d の上部に一部重ねる構造とした。この構造でなくとも、透過電極 8a の一部に上記接続用金属層 9d の一部を重ねてもよい。尚、本実施形態でも透過電極 8a として ITO を用いた。

【0073】このとき、ソース配線 9a、ソース電極 9b、ドレイン電極 9c、接続用金属層 9d が、透過電極 8a の上層に形成されていても構わない。

【0074】次に、上記実施形態 1 と同様の方法にて層間絶縁膜 10 を形成し、コンタクトホール 13 及び透過領域（領域 A）の部分の層間絶縁膜 10 を開孔した後、反射電極 11 を形成する。本実施形態でも反射電極 11 の材料として Al を用いた。

【0075】以上説明したように、本実施形態において

も反射電極 11 としてのと透過電極 8 a としての ITO とを直接接続させず、特に信頼性においてコンタクト部での A1 と ITO との電食による不良の発生を抑えることができる。この接続用金属層は TFT のソース電極の材料で形成することができるため、その製造を簡略化することができる。

【0076】（実施形態 3）本実施形態では、上記実施形態 2 の液晶表示パネルの別の製造方法について、図面にに基づき説明を行なう。

【0077】図 6 (a) ~ (c) は、本実施形態の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図であつて、図 5 の B-B 断面に相当する。尚、説明は省略するが、本実施形態において層間絶縁膜を形成する以前の工程は、上記実施形態 2 にて説明した方法に準じて行なったものとする。

【0078】以下に詳細に説明する。まず、上記実施形態 2 と同様の方法により層間絶縁膜 10 を形成した後、図 6 (a) に示すように、フォトリソグラフィ技術を用いてコンタクトホール 13 領域の層間絶縁膜 10 を削除する。このとき、同一工程において反射電極 11 を形成する部分の層間絶縁膜 10 表面には入射光を散乱させるための凹凸部 15 を上記実施形態 1 と同様に形成する。尚、上記実施形態とは異なり、領域 A となる部分の層間絶縁膜 10 は削除しない。

【0079】そして、その上層に反射電極 11 用の A1、若しくは A1 系合金膜を成膜する。本実施形態では層間絶縁膜 10 として単層の有機樹脂を用いた。但し、層間絶縁膜 10 は異なる複数材料からなる積層膜であっても構わない。また、必要なければ表面の凹凸は形成しなくても構わない。

【0080】次に、図 6 (b) に示すように、上記 A1 をフォトリソグラフィ技術によってパターンニングし、反射電極 11 を形成する。

【0081】その後、図 6 (c) に示すように透過領域（領域 A）を覆う層間絶縁膜 10 のすべて若しくは一部を除去する。

【0082】以上により、透過型表示と反射型表示を同時に行なう本実施形態の液晶表示パネルにおいて、反射電極 11 としての A1 と透過電極 8 a としての ITO の直接接続を行わない構造を取り、信頼性においてコンタクト部での A1 と ITO との電食による不良の発生を抑えることのでき、かつ製造工程においても反射電極材料の A1 の加工プロセス時に透過電極 8 a の ITO が露出しないことにより、製造中の A1 と ITO との電食反応を抑制できる、液晶表示パネルを製造できる。

【0083】（実施形態 4）本発明の実施形態 4 の液晶表示パネルの製造方法に関し、図面に基づき以下に説明を行なう。本実施形態の液晶表示パネルは、画素電極としての透過電極 8 a、及び TFT のドレイン電極 9 c の形成順序と、層間絶縁膜 10 を開孔する工程が上記実

施形態 2、3 と相違する。

【0084】図 7 (a) ~ (c) は、本実施形態の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図であつて、図 5 の B-B 断面に相当する。尚、説明は省略するが、本実施形態において半導体コンタクト層を形成する以前の工程は、上記実施形態 1、2 にて説明した方法に準じて行なったものとする。

【0085】以下に詳細に説明する。図 7 (a) に示すように、半導体コンタクト層を形成した後、光透過性導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いてパターンニングすることにより透過電極 8 a を形成する。本実施形態では透過電極 8 a として ITO を用いた。

【0086】次に導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いてソース配線 9 a、ソース電極 9 b、ドレイン電極 9 c、接続用金属層 9 d、及び透過領域用金属層 9 e をパターンニングする。ソース配線 9 c とソース配線 9 a とは電気的に接続されている。また、ドレイン電極 9 c、接続用金属層 9 d、及び透過領域用金属層 9 e は互いに電気的に接続されている。本実施形態では上記導電膜として Ta 系材料を用いた。但し本材料としては A1、Cr、Mo、W、Cu、Ti 等の導電性を有する他の材料でも構わない。

【0087】次にソース電極 9 b、ドレイン電極 9 c をマスクとして半導体コンタクト層をエッチングし、ソース側 6 a、とドレイン側 6 b に分けることで TFT を形成する。

【0088】この後、層間絶縁膜 10 を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて透過領域 A に対応する部分及びコンタクトホール 13 の部分の層間絶縁膜 10 を開孔する。このとき、反射電極 11 を形成する部分の層間絶縁膜 10 表面には入射光を散乱させるための凹凸部 15 を形成する。そして、その上層に反射電極 11 用の A1、若しくは A1 系合金膜を成膜する。尚、本実施形態では層間絶縁膜 10 として単層の有機樹脂を用いた。但し層間絶縁膜は異なる材料の積層膜であっても構わない。或いは表面に凹凸を形成しなくても構わない。

【0089】図 7 (b) に示すように、上記 A1 をフォトリソグラフィ技術によってパターンニングし反射電極 11 を形成する。

【0090】この後、図 7 (c) に示すように、透過領域（領域 A）上を覆っている金属層 9 e のすべて若しくは一部を除去する。このとき、金属層 9 e の除去は、フォトリソグラフィ技術を用いることによって、或いは、反射電極 11 をマスクとしてエッチング除去しても構わない。または、反射電極 11 のエッチング形成時に連続してエッチング形成しても構わない。

【0091】以上本実施形態の液晶表示パネル及びその製造方法は、A1 の反射電極と ITO の透過電極 8 a の直接接続を行わないため、信頼性についてはコンタクト部での A1 と ITO との電食による不良の発生を抑える

ことができ、かつ、製造工程については反射電極材料の Al の加工プロセス時に透過電極 8 a の ITO が露出しないため、製造中の Al と ITO との電食反応を抑制できるという利点を有する。

【0092】（実施形態 5）本発明の実施形態 5 の液晶表示パネルの製造方法に関し、図面にに基づき以下に説明を行なう。本実施形態の液晶表示パネル及びその製造方法は、透過電極 8 a 及び TFT7 の構造、層間絶縁膜 10 に開孔部を設ける工程に特徴があり、この点で上記実施形態 2、3 と相違する。

【0093】図 8 (a) ~ (c) は、本実施形態の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図であって、図 5 の B-B 断面に相当する。尚、説明は省略するが、本実施形態において半導体コンタクト層を形成する以前の工程は上記実施形態 1、2 にて説明した方法に準じて行なったものとする。

【0094】以下に詳細に説明する。図 8 (a) に示すように、半導体コンタクト層を形成した後に、光透過性導電膜と金属膜を連続して成膜し、ソース配線 9 a、ソース電極 9 b、ドレイン電極 9 c、反射電極-透過電極接続用金属層 9 d、及び透過領域用金属層 9 e としてフォトリソグラフィ技術を用いて金属膜をパターンニングする。続いて下層の光透過性導電膜を、前記ソース配線 9 a、ソース電極 9 b、ドレイン電極 9 c、反射電極-透過電極接続用金属層 9 d、及び透過領域用金属層 9 e と同一のパターンに加工し、透過電極 8 a、ソース電極 8 b、ドレイン電極 8 c 等を形成する。

【0095】すなわち、ソース電極、ソース配線、ドレイン電極を二層構造とすることにより、一方の層の一部に何らかの断線不良が生じている場合にも正常な信号は他方の層を伝播するため、正常に表示を行うことができる。また、本実施形態では光透過性導電膜として ITO、金属膜として Ta 系材料を用いた。このとき光透過性導電膜の加工に関しては、金属膜と連続してエッチング加工しても、また金属膜を加工するときに用いたマスクを除去した後、金属膜のパターンを用いて光透過性導電膜をエッチング加工しても構わない。

【0096】次にソース電極 9 b、8 b とドレイン電極 9 c、8 c をマスクとして半導体コンタクト層をエッチングし、ソース側 6 a とドレイン側 6 b に分けることで TFT7 を形成する。

【0097】続いて、層間絶縁膜 10 を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて層間絶縁膜 10 に透過領域（領域 A）とコンタクトホール 13 の部分を開孔する。このとき、反射電極 11 を形成する部分の層間絶縁膜 10 表面には入射光を散乱させるための凹凸部 15 を形成する。そして、その上層に反射電極 11 としての Al、若しくは Al 系合金膜を成膜する。

【0098】本実施形態では該層間絶縁膜に単層の有機樹脂を用いた。但し層間絶縁膜は複数の異なる材料の積

層膜であっても構わない。また表面に凹凸を形成しなくても構わない。

【0099】次に、図 8 (b) に示すように前記 Al または Al 系合金膜をフォトリソグラフィ技術によってパターンニングし、反射電極 11 を形成する。

【0100】その後、図 8 (c) に示すように領域 A 上を覆っている金属層 9 e のすべて若しくは一部を除去する。このとき、金属層 9 e の除去は、フォトリソグラフィ技術によって行なってもよいし、或いは、反射電極 11 をマスクとしてエッチングすることにより行なってもよい。さらに、反射電極 11 のエッチング形成時に連続してエッチング形成しても構わない。

【0101】以上本実施形態の液晶表示パネル及びその製造方法は、Al の反射電極と ITO の透過電極 8 a の直接接続を行わないため、信頼性についてはコンタクト部での Al と ITO との電食による不良の発生を抑えることができ、かつ、製造工程については反射電極材料の Al の加工プロセス時に透過電極 8 a の ITO が露出しないため、製造中の Al と ITO との電食反応を抑制できるという利点を有する。さらに、画素電極の形成を、他の配線と同一プロセスにて行うため、製造工程を簡略化することができる。

【0102】尚、本実施形態では、画素電極の形成をソース配線、ソース電極及びドレイン電極と同一の工程にて行ったがこれに限定されることはなく、ゲート配線またはゲート電極と同一工程にて形成してもよいし、画素電極としては透過電極ではなく反射電極を他の配線と同一工程にて形成するものであってもよい。

【0103】（実施形態 6）本発明の実施形態 6 の液晶表示パネル及びその製造方法に関し、図面にに基づき以下に説明を行なう。また、本実施形態においては、上記実施形態 6 の液晶表示パネルに関し、端子部の構造及びその製造方法についても説明を行なう。

【0104】本実施形態の液晶表示パネル及びその製造方法は、透明電極をゲート電極及びゲート配線と同層に設ける点で上記実施形態 1 ~ 5 と相違する。

【0105】図 9 (a) ~ (c) は、本実施形態の液晶表示パネルに用いるアクティブマトリクス基板の画素部および液晶パネル端子部の構造を説明するための断面図である。尚、図 9 (a) は本実施形態に係るアクティブマトリクス基板の画素部の断面構造を示す図であり、図 4 の B-B 断面に相当する。また、図 9 (b) はゲート側端子構造を示す図であり、図 10 の C-C 断面に相当し、図 9 (c) はソース側端子構造を示す図であり、図 10 の D-D 断面に相当する。また、ここで図 10 は本発明の液晶パネルの概略上面図である。

【0106】以下に、本実施形態の液晶表示パネルに係る構成について詳細に説明する。図 9 (a) において、絶縁性基板 1 上には、上記実施形態と同様の TFT7 が設けられている。また、この TFT7 のゲート電極 2 及

びゲート配線（図示せず）と同層に、透過電極 8 a が設けられている。さらに、TFT7 のドレイン電極 9 c は、層間絶縁膜 10 中に形成されたコンタクトホール 13 を介して上層の反射電極 11 と接続されていると共に、他方、ゲート絶縁膜 4 に形成されたコンタクトホール 16 を介して下層の透過電極 8 a と接続されている。

【0107】この構成により、本実施形態のように、画素電極として互いに異種金属からなる透過電極及び反射電極を同一画素内に作り込む構成とする場合に、例えば、透過電極 8 a の加工工程後より、反射電極 11 の加工工程が終了するまでの間に、少なくとも透過電極 8 a が形成された部分を少なくともゲート絶縁膜 4 で被覆し続けることにより、各金属間の電極電位差により電食が発生する問題を防ぐことができる。

【0108】また、図 9 (b)、(c) に示す端子部構造についても同様に、上記透過電極 8 a と同時に形成された端子部の上部に絶縁膜（ゲート絶縁膜 4 及び層間絶縁膜 10）が設けられた構成となっているので、層間絶縁膜の形成後に形成される反射電極 11 の加工工程が終了するまでの間、下層の端子部を少なくともより緻密なゲート絶縁膜によって被覆しておくことが可能なので、異種金属である反射電極と端子部間での電食の発生を阻止することができる。

【0109】以下に、図 9 (a) のアクティブマトリクス基板の製造方法について図 11、12 を参照しながら説明を行なう。尚、図 11、12 は図 9 (a) のアクティブマトリクス基板の製造方法を説明するための断面図である。

【0110】図 11 (a) において、絶縁性基板 1 上に透過性を有する導電膜を形成し、フォトリソグラフィ技術により透過電極 8 a を形成する。本実施形態では、絶縁性基板 1 としてガラス基板、透過電極 8 a としてはITOを用いた。

【0111】また、フォトリソグラフィ技術により、ゲート電極 2、ゲート配線 3 をパターンニングする。本実施形態ではゲート材料として Ta 系材料を用いた。但し、ゲート材料としては Al、Cr、Mo、W、Cu、Ti 等の導電性を有する他の材料であってもよい。

【0112】尚、以上の工程においては、透過電極 8 a の形成工程と、ゲート電極 2 及びゲート配線 3 の形成工程の順序を入れ替えることもできる。

【0113】次に、図 11 (b) において、ゲート絶縁膜 4、半導体層 5、半導体コンタクト層 6 a、6 b として、それぞれ SiNx、アモルファスシリコン、P をドーピングした n+ 型アモルファスシリコンを CVD 法により連続成膜し、フォトリソグラフィ技術により半導体層 5、半導体コンタクト層 6 a、6 b をパターンニングする。

【0114】さらに、ゲート絶縁膜 4 に、透過電極 8 a と、後に形成するドレイン電極とを電気的に接続するた

めのコンタクトホール 15 を形成する。尚、このとき、図 9 (b)、(c) に示すゲート側端子 20 またはソース側端子 21 上のゲート絶縁膜 4 を同時に除去しても構わない。

【0115】続いて、図 11 (c) に示すように、導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ技術によりソース配線 9 a、ソース電極 9 b 及びドレイン電極 9 c をパターンニングする。本実施形態ではこの導電膜として Cr 系材料を用いた。但し、他にも Al、Mo、Ta、W、Cu、Ti 等の導電性を有する材料を用いてもよい。

【0116】次に、ソース電極 9 b、ドレイン電極 9 c をマスクとして半導体コンタクト層 6 a、6 b の中央部をエッチングすることにより、ソース側 6 a とドレイン側 6 b とに分ける。以上の工程により TFT7 が完成する。

【0117】続いて、図 11 (d) に示すように、層間絶縁膜 10 を成膜し、フォトリソグラフィ技術を用いて層間絶縁膜 10 にコンタクトホール 13 を開孔する。但し、透過領域（領域 A）に対応する層間絶縁膜 10 については本工程では除去せず、後程、反射電極を形成した後

に除去する。

【0118】次に、図 11 (e) に示すように、領域 B に対応する層間絶縁膜 10 の表面に凹凸部 15 を、前工程と同様にフォトリソグラフィによって形成する。

【0119】尚、本実施形態では層間絶縁膜 10 としては有機絶縁膜を用いたが、これに限らず、異なる材料の積層膜であってもよい。また、層間絶縁膜 10 の表面には必ずしも凹凸を形成しなくても構わない。

【0120】次に、図 12 (a) に示すように、反射電極 11 の材料として反射効率の高い導電膜を成膜する。

【0121】さらに図 12 (b) に示すように、フォトリソグラフィ技術により反射電極 11 をパターンニングする。画素内においては、少なくとも領域 A となる部分の反射電極 11 は除去するものとする。

【0122】最後に、図 12 (c) に示すように、領域 A に相当する透過電極 8 a 上の層間絶縁膜 10 を除去する。さらに、ゲート絶縁膜 4 についても、領域 A に相当する部分を除去する。

【0123】尚、このとき、ゲート絶縁膜 4 または層間絶縁膜 10 を残存させると電圧降下が生じ、液晶へ電圧が十分に印加されないことが懸念されるため、何れの絶縁膜も除去しておくことが好ましい。特に、本発明のように、互いに電気的に接続された透過電極 8 a と反射電極 11 によって液晶へ電圧を印加するときには、領域 A、B に対応する液晶へ印加される電圧には差が生じてしまうため、好適ではない。

【0124】以上の方法により、アクティブマトリクス基板が完成する。さらに、このアクティブマトリクス基板に、配向膜を塗布後、必要ならば配向処理を行ない、上述の対向基板と貼り合せ、基板間に液晶を封入するこ

10

20

30

40

50

とにより本発明の液晶表示パネルが完成する。

【0125】以下、基板周縁部に設けられた端子部の形成方法について図13を参照しながら説明を行なう。

【0126】図13は、本実施形態の液晶表示パネルに係るゲート側端子部の製造方法を説明するための図である。尚、この端子部については、上述した画素部の形成工程と同時に形成することが可能である。

【0127】図13(a)において、絶縁性基板1上に、ゲート側端子20として透明導電膜を形成する。尚、この工程と同時に、画素部においては透過電極を形成する。この後、端子20の上にゲート配線3を形成することによって、端子20とゲート配線3とが電気的に接続される(図11(a)の工程に対応)。

【0128】次に、図13(b)において、ゲート配線3及びゲート側端子部20上にゲート絶縁膜4を成膜する。尚、端子20上のゲート絶縁膜4の除去は本工程では行わず、後の工程にて行なう(図11(b)の工程に対応)。

【0129】この後、画素部においてはTFTを完成させる(図11(c)の工程に対応)。

【0130】図13(c)において、ゲート絶縁膜4上に層間絶縁膜10を成膜する(図11(d)の工程に対応)。

【0131】図13(d)において、層間絶縁膜10上に反射電極11となる導電膜を成膜する(図12(a)の工程に対応)。

【0132】図13(e)において、端子部近傍に成膜されていた反射電極11を除去する。尚、この工程と同時に、画素内においては、領域Aに形成されていた反射電極11を除去する(図12(b)の工程に対応)。

【0133】図13(f)において、端子20上のゲート絶縁膜4及び層間絶縁膜10を除去する。尚、この工程と同時に、画素内では領域Aにあるゲート絶縁膜4と層間絶縁膜10を除去する(図12(c)の工程に対応)。

【0134】以上のように、画素領域のみならず端子部においても、反射電極11の加工工程が終了するまで、端子20及びゲート配線3が絶縁層(ゲート絶縁膜4、層間絶縁膜10)によって被覆されるので、互いに異種金属である端子20及びゲート配線3と、反射電極11との間で電食が生じるのを阻止することが可能である。

【0135】尚、詳細な説明は省略するが、図9(c)に示すソース端子部についても、画素部の形成工程と同時に形成することができ、かつ、ゲート端子部同様に電食の発生を阻止することが可能である。

【0136】また、画素部において、透過電極8aを形成する工程(図11(a)に示す工程)とゲート電極2及びゲート配線3を形成する工程(図11(b)に示す工程)の順序を逆にした場合にも、有効に電食の発生を阻止することが可能である。

【0137】このときのゲート側端子構造を図14(a)に、ソース側端子構造を図14(b)に示す。

尚、何れの端子部においても、端子はゲート電極及びゲート配線を構成するゲート材料と、透過電極8を構成する透明導電膜からなる二層構造となっている。この場合にも、反射電極の加工工程が終了するまでの間、端子を少なくともゲート絶縁膜により被覆しつづけることができるので、電食の発生を効果的に阻止することが可能である。

10 【0138】(実施形態7) 上記実施形態6にて説明した図11(c)に続く工程としては、図15(a)～(c)に示すような方法を用いても、有効に電食を阻止することが可能である。本実施形態では、上記実施形態6に係るアクティブマトリクス基板の他の製造方法について以下に説明を行なう。

20 【0139】図15(a)において、層間絶縁膜10を成膜し、フォトリソグラフィによりコンタクトホール13を開孔すると同時に、領域Aに相当する部分の層間絶縁膜を除去する。また、領域Bに相当する部分の層間絶縁膜10表面には凹凸部15を形成しておく。

【0140】次に、図15(b)に示すように、層間絶縁膜10上に反射電極11として導電膜を成膜する。

【0141】最後に、図15(c)に示すように、領域Aに相当する部分に形成されている反射電極11を除去する。

30 【0142】このプロセスによっても反射電極11の加工工程が終了するまで、下部の透過電極8aがゲート絶縁膜4によって被覆されるので、反射電極11と透過電極8aとを異種金属で形成した場合に生じ易い電食の発生が食い止められる。但し、本プロセスでは透過電極8aを被覆する絶縁層としては、ゲート絶縁膜4の一層のみとなるので図11、12に示すプロセスの方がより有効に電食反応を阻止することができる。

【0143】また、このプロセスによれば、図15

(a)に示す通り、コンタクトホール13の形成と同時に領域Aに相当する層間絶縁膜を除去するので、図11、12に示すプロセスと比較して、工程数を低減することが可能である。

【0144】

40 【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の液晶表示パネル及びその製造方法によれば、画素電極が互いに電気的に接続された光透過効率の高い層と光反射効率の高い層とを同一画素領域内に有しているので、従来のハーフミラーを用いた液晶表示パネルと比較して周囲光や照明光をロスなく利用する事ができ、格段に光の利用効率を向上させることができる。光透過効率の高い層としては例えば透明導電性膜であるITOやSnO₂等、光反射効率の高い層としてはAl、W、Crやそれらの合金等、何れも一般的な反射型液晶表示パネルや
50 透過型液晶表示パネルに使用している材料を用いること

ができるため製造が簡単で、表示特性及び信頼性の点で非常に安定した液晶表示パネルを実現することができる。

【0145】また、従来の透過型液晶表示パネルが有していた、周囲光が明るい環境下で表面反射により視認性が低下するという課題と、従来の反射型液晶表示パネルが有していた周囲光が暗い環境下でパネル輝度低下により表示観察が困難となるという課題の両方を同時に解消することができると共に、何れの特長をも有する優れたものとなった。

【0146】すなわち、本発明の液晶表示パネルは十分な電源を供給できる環境下では従来の透過型液晶表示パネルと同様にバックライト光を利用するため、周囲光の強度にかかわらず表示認識が可能となり、上述の反射特性のばらつきによる周囲光の利用効率のばらつきも反射型液晶表示パネルほど緻密に制御する必要はない。使用にあたっては、同一画素内において光透過効率の高い層と光反射効率の高い層とが相補的に表示に寄与するので、周囲光がどんな明るさであっても画像は鮮明に表示される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明実施形態 1 の液晶表示パネルを説明するための平面図である。

【図 2】本発明実施形態 1 の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

【図 3】本発明実施形態 1 の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図である。

【図 4】本発明実施形態 2 の液晶表示パネルを説明するための平面図である。

【図 5】本発明実施形態 2 の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

【図 6】本発明実施形態 3 の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

【図 7】本発明実施形態 4 の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

【図 8】本発明実施形態 5 の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

【図 9】本発明実施形態 6 の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

【図 10】本発明の液晶表示パネルの概略平面図である。

【図 11】本発明実施形態 6 の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図である。

【図 12】本発明実施形態 6 の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図である。

【図 13】本発明実施形態 6 の液晶表示パネルのゲート側端子部の製造方法を説明するための断面図である。

【図 14】本発明実施形態 6 の液晶表示パネルの別の端子部構造を説明するための断面図である。

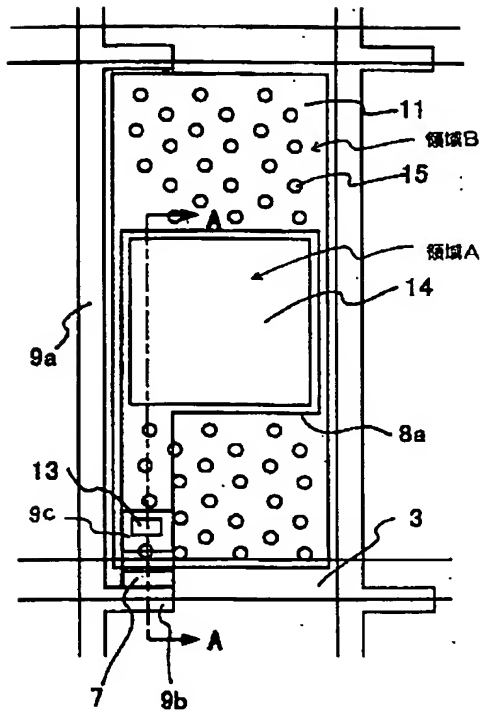
【図 15】本発明実施形態 7 の液晶表示パネルの製造方法を説明するための断面図である。

【図 16】従来の液晶表示パネルを説明するための断面図である。

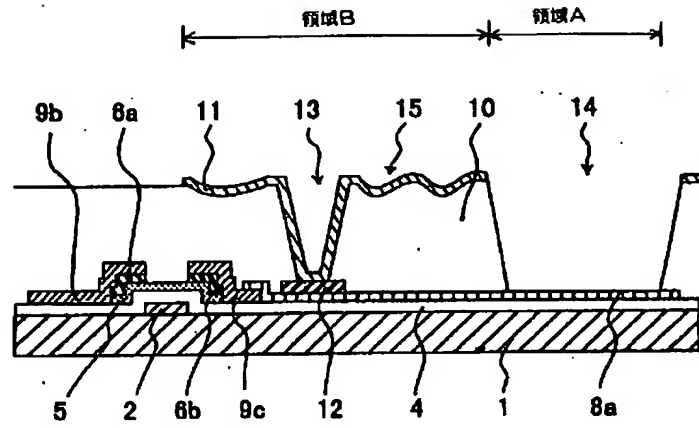
【符号の説明】

1	絶縁性基板
2	ゲート電極
3	ゲート配線
4	ゲート絶縁膜
5	半導体層
6 a	半導体コンタクト層（ソース電極側）
6 b	半導体コンタクト層（ドレイン電極側）
7	T F T
8 a	透過電極
8 b	ソース電極（透過電極材料）
8 c	ドレイン電極（透過電極材料）
9 a	ソース配線
9 b	ソース電極
9 c	ドレイン電極
9 d	（反射電極－透過電極接続用）金属層
9 e	（透過領域用）金属層
10	層間絶縁膜
11	反射電極
12	金属層
13	（ドレイン）コンタクトホール
15	凹凸部
20	端子（ゲート配線側）
21	端子（ソース配線側）

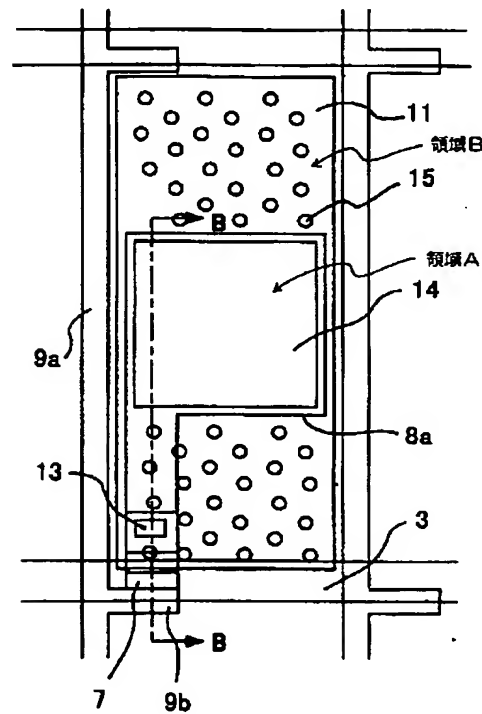
【図 1】



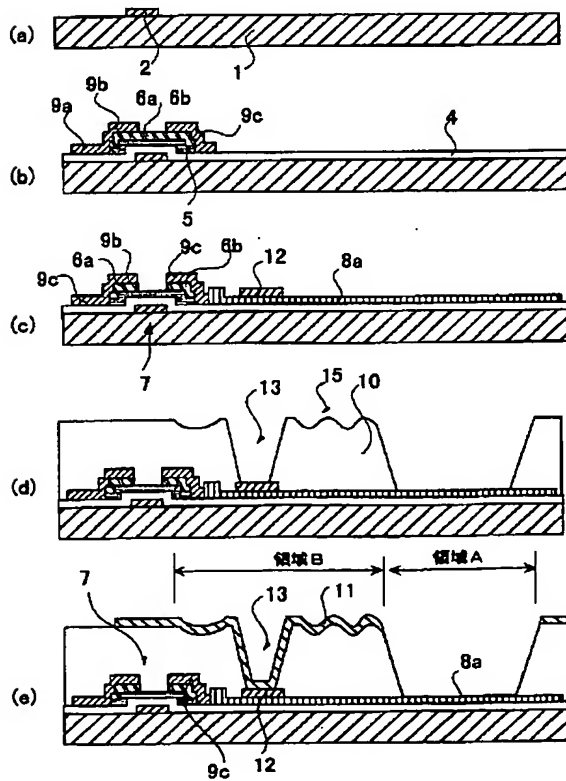
【図 2】



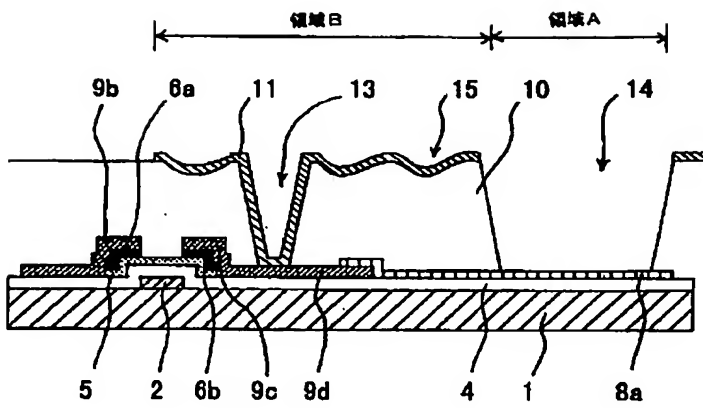
【図 4】



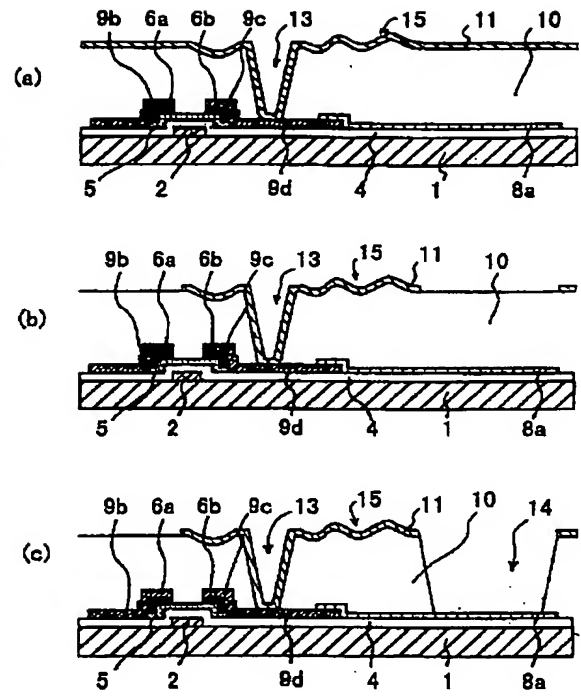
【図 3】



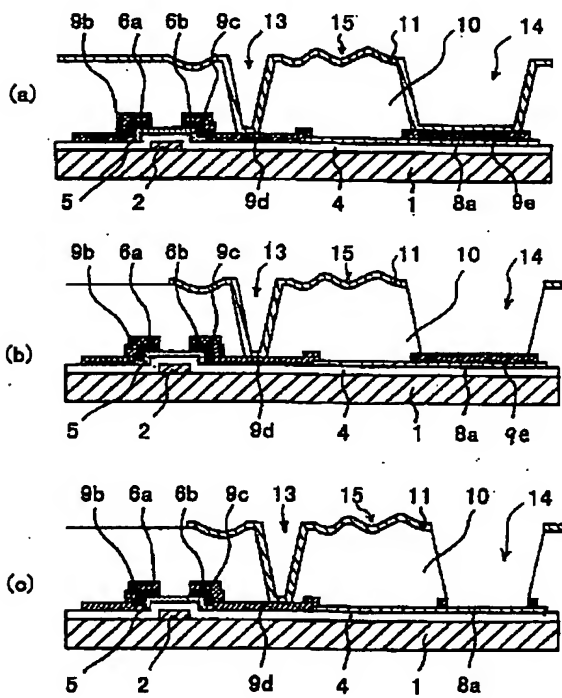
【図 5】



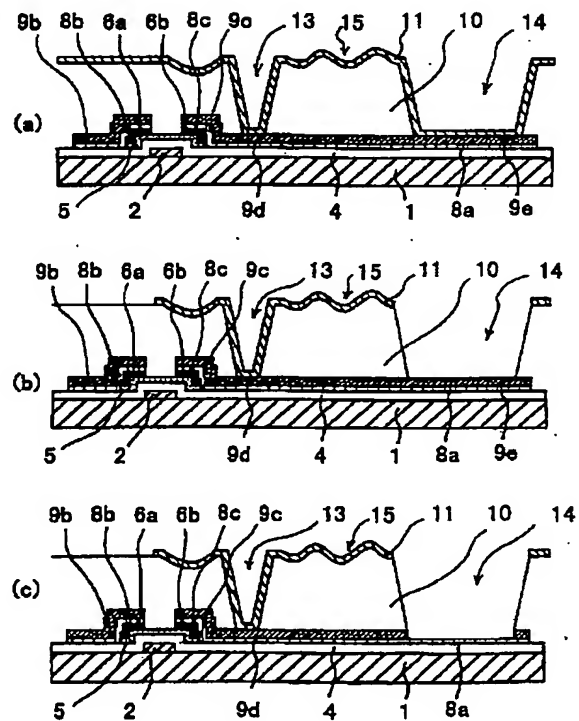
【図 6】



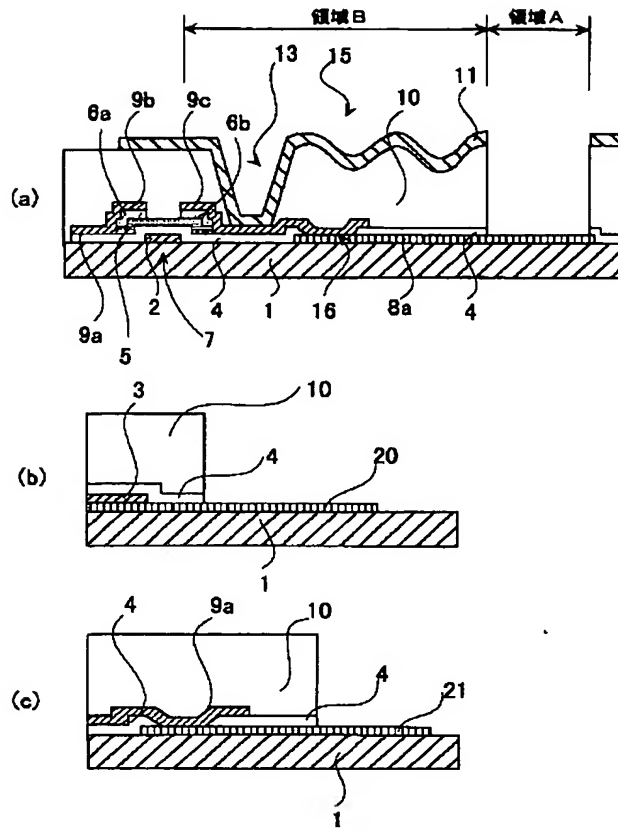
【図 7】



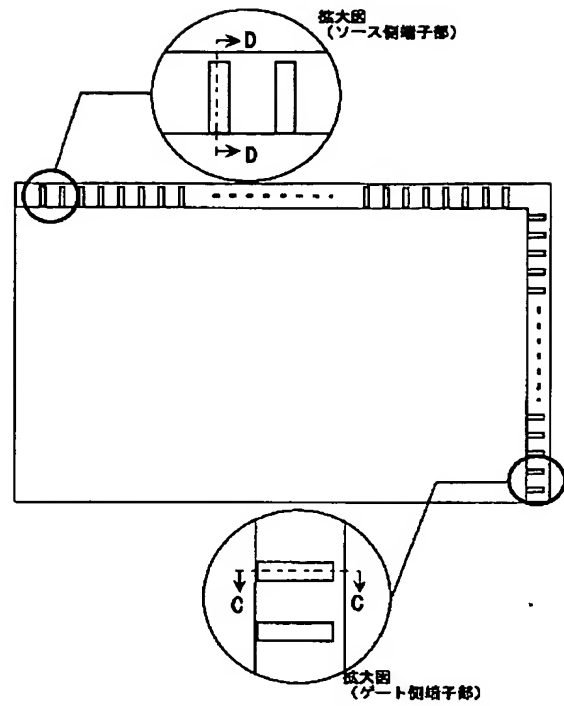
【図 8】



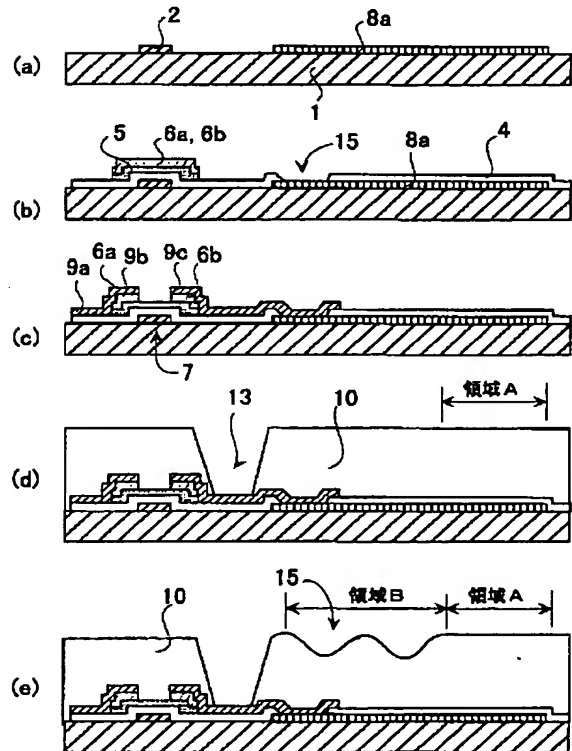
【図 9】



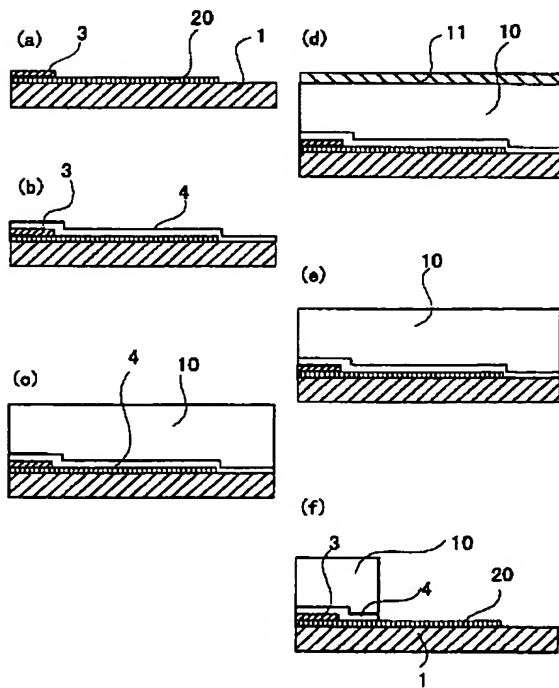
【図 10】



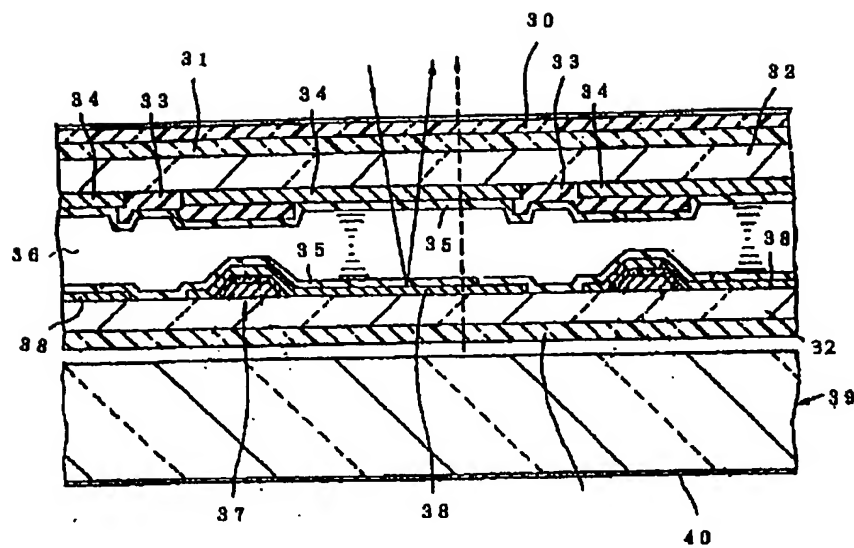
【図 11】



【図 13】



【図 1 6】



フロントページの続き

(72)発明者 鳴瀧 陽三
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内
(72)発明者 島田 尚幸
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72)発明者 片山 幹雄
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内
(72)発明者 吉村 洋二
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内
(72)発明者 石井 裕
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内